

平成25年7月3日

半導体工学・演習のレポート課題

松浦

課題1 アクセプタ密度が N_A の p 型半導体とドナー密度が N_D の n 型半導体の pn 接合の拡散電位 V_d が

$$V_d = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_D N_A}{n_i^2} \right)$$

となることを証明しよう。ただし、アクセプタもドナーもすべてイオン化している。

次回（7月10日）に、A4のレポート用紙で提出すること。